

产品目录

Chanyinmlu



国营永红器材厂

产品目录



国营永红器材厂

1 9 7 6 年

毛主席语录

中国人民有志气，有能力，一定要在不远的将来，赶上和超过世界先进水平。

编 制 说 明

1. 本目录编入1975年底为止的我厂生产和试制产品。
2. 全部产品的技术规范均按四机部部颁标准规定，没有部标的，暂按厂标规定，待部标下达后，一律以部标为准。
3. 用户对产品如有特殊要求，可另行商议。
4. 为提高产品质量，希望用户在使用过程中及时提出宝贵意见。
5. 本目录编印仓促，错漏之处，欢迎批评指正。

半 导 体 零 部 件

目 录

半 导 体 零 部 件

半导体零部件型号命名方法.....	(1)
半导体零部件使用说明.....	(4)
B—1 管帽	(5)
B—1A 管座	(6)
B—1C 管座	(7)
B—1D 管座	(8)
B—1E 管座	(9)
TO—12 (原TO—4).....	(10)
TO—14 (原TO—5).....	(11)
JST—14	(12)
JST—24	(13)
JST—40.....	(14)

JBB—14 (原GB—14)	(15)
JSS—14 引线.....	(16)
JSS—16 引线.....	(17)
S—3引线.....	(18)
JSS—18 引线.....	(19)
JSB—14 引线.....	(20)
JBB—18	(21)

半 导 体 三 极 管

半导体器件型号命名法.....	(22)
半导体三极管参数符号说明.....	(23)
半导体三极管使用说明.....	(24)
外延平面型硅PNP小功率开关管 3CK3 参数表.....	(25)
外延平面型硅PNP低噪声小功率管GD301参数表.....	(27)
外延平面型硅PNP超高频小功率管3CG25参数表.....	(31)
外延平面型硅PNP 超高频小功率管 3CG 18 参数表.....	(29)
外延基区平面型硅PNP高频小功率管3CG14参数表.....	(38)
外延基区平面型硅PNP高频小功率管3CG15参数表.....	(35)

外延平面型硅PNP高频小功率管3CG22参数表	(37)
外延平面型硅PNP高频中功率管3CG51参数表	(39)
外延平面型硅PNP超高频小功率管3CG26参数表(试制)	(41)
硅PNP微型三极管3CG15X、3CG22X参数表(芝麻管)	(43)
外延平面型硅PNP高频中功率三极管3CG71参数表	(45)
外延平面型硅PNP高频中功率高反压三极管3CG75参数表	(47)
外延平面型硅PNP高频大功率管3CA1参数表(试制)	(49)
外延平面型硅PNP高频大功率高反压管3CA5参数表(试制)	(51)
外延平面型硅PNP微功耗三极管3CW11参数表	(53)

线性集成电路

8FC—75型低功耗通用运算放大器	(54)
试制产品	(75)
一、集成电路高速放大器	
二、集成电路注入逻辑	
1.十进计数译码器	
2.六十进制计数译码器	

3. 触发器

4. 移位寄存器

三、集成电路稳压电源

半导体零部件型号命名方法

(企业标准 Q/CA 3—73)

- 一、B型、按四机部部颁标准 SJ 139—70 “半导体三极管外形尺寸”统一命名。
- 二、TO型按四机部推荐标准命名，“TO”表示集成电路的圆形金属外壳，破折号后面的阿拉伯数字表示其引出线数目。
如TO—12表示有12条引出线的集成电路圆形金属外壳。
- 三、JFJ型、JST型、JBB型、JSS型命名方法：

1. 其型号由四个部分组成：

J ——

第四部分：用阿拉伯数字表示引出线数目

第三部分：用汉语拼音字母表示封装材料

第二部分：用汉语拼音字母表示封装形式

第一部分：J为“集”字汉语拼音的第一个字母，表示集成电路的封装

示例

J S T —— 24

24条引出线

陶瓷外壳

双列直插式

集成电路的封装

2. 型号组成部分的符号及其意义:

符 号 组 成 部 分	符 号	意 义
第一部分	J	表示此外壳适用于集成电路的封装
	F	表示封装形式为F型
第二部分	S	表示封装形式为双列直插式
	B	表示封装形式为扁平式
第三部分	J	表示封装材料为金属
	T	表示封装材料为陶瓷
	S	表示封装材料为塑料
	B	表示封装材料为玻璃陶瓷
第四部分		表示引出线数目

半 导 体 零 部 件 使 用 说 明

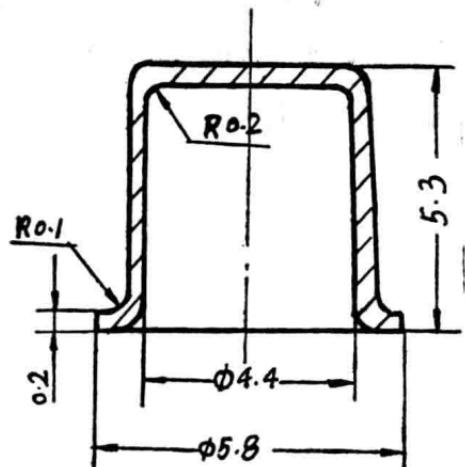
- 一、本目录所列之产品用途仅供参考。
- 二、产品的技术要求和验收方法均按四机部部颁标准“半导体零部件技术要求和验收方法”（修订稿）和我厂企业标准 CA0.005.001JT “半导体零部件总技术条件”（暂行）规定。
- 三、半导体零部件可齐套供应，也可单供某件。

B—1 管 帽

用途: 适用于硅和锗高、低频小功率管和开关
管的封装

材料: 10号钢带

涂复: 镀镍

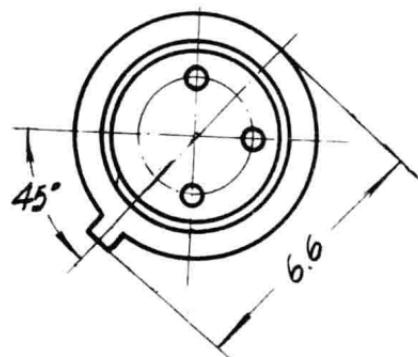
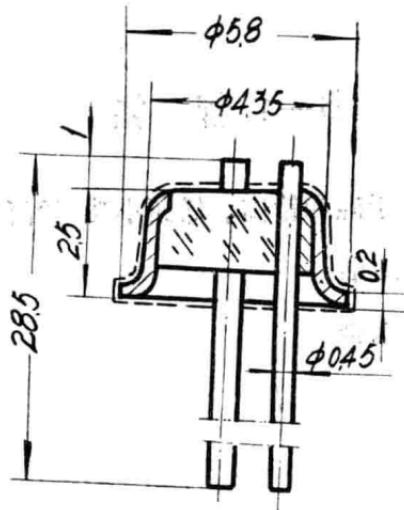


B—1A 管 座

用途：适用于硅、锗低频小功率管的封装

材料：可伐带、8号玻璃和可伐丝

涂复：先镀镍再镀金

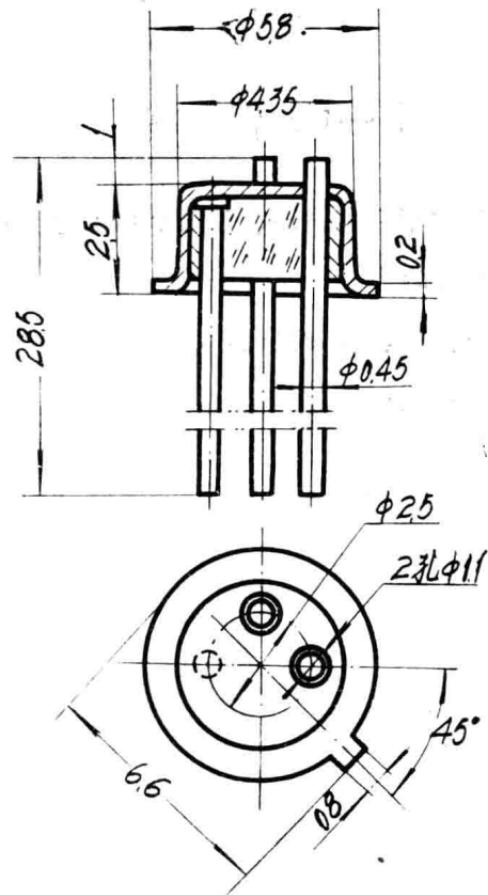


B—1C 管 座

用途: 适用于硅和锗高、低频小功率管和开关
管的封装

材料: 可伐带、8号玻璃和可伐丝

涂复: 先镀镍再镀金



B-1D 管 座

用途: 适用于硅和锗高、低频小功率管和开关管的封装

材料: 可伐带、8号玻璃和可伐丝

涂复: 先镀镍再镀金

